

257610



2576 10

P A T E N T E   D E   I N V E N C I O N

Por V E I N T E años

en España, a favor de Don Blas MILLANES GARCIA,  
de nacionalidad española, residente en Madrid,  
calle Serrano, nº. 84-32., cuya patente tiene  
por objeto:

"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE UN DISPO-  
SITIVO DE EFECTO TRANSISTOR".

.....

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

Constituye la finalidad de la invención la  
realización de un dispositivo de efecto tran-  
sistor mediante el adecuado acoplamiento eléc-  
trico de tres diodos.

5.-

El dispositivo que nos ocupa representa  
una innovación fundamental con relación a los

/...



5.-

transistores ordinarios como se desprende de la simple inspección de su montaje, presentando además con relación a ellos las ventajas de su mayor facilidad de fabricación y economía de coste.

10.-

Para la práctica del invento se utilizan tres electrodos entre los cuales se acoplan eléctricamente dos diodos en oposición; el electrodo central constituye la base del transistor y los otros dos el emisor y colector, respectivamente. Entre los electrodos emisor y colector, y en oposición con el primero de ellos, se conecta otro diodo.

15.-

Las características del dispositivo obtenido mediante este montaje y, particularmente, el efecto transistor buscado, dependen fundamentalmente de la naturaleza del material utilizado para la fabricación de los diodos, así como de los valores de las resistencias directa e inversa de los mismos y de las capacidades propias y distribuidas.

20.-

Descrita convenientemente la naturaleza del actual invento como asimismo la forma de poderlo llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable, se hace constar a los efectos oportunos que el invento no queda rigurosamente limitado a los detalles exactos de esta exposición, ya que en el mismo serán susceptibles de introducirse todas aquellas modifica-

25.-



257610 2

ciones de detalle que las circunstancias o la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan no se altere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

5.-

N O T A

Se declaran como de novedad y propiedad para todo el territorio nacional, el contenido de las siguientes:

10.-

R E I V I N D I C A C I O N E S:

1a).-Procedimiento de fabricación de un dispositivo de efecto transistor, que se caracteriza porque entre tres electrodos, de los cuales el central actúa de base y los dos exteriores de emisor y colector respectivamente, se conectan eléctricamente dos diodos de tal manera que entre cada dos electrodos se encuentra intercalado un diodo, cuyos diodos se acoplarán de forma que el uno bloquee la corriente que el otro deje pasar.

15.-

20.-

2a).- Procedimiento de fabricación de un dispositivo de efecto transistor, caracterizado porque entre los electrodos emisor y colector mencionados en la reivindicación anterior y en oposición con el electrodo emisor, se acopla eléctricamente otro diodo.

25.-

3a).- Procedimiento de fabricación de un dispositivo de efecto transistor, caracteriza-

